

Medium Power Transistor (-50V, -1A)

2SA1900

● Features

- 1) Low saturation voltage, typically $V_{CE(sat)} = -0.15V$ at $I_C / I_S = -500mA / -50mA$.
- 2) $P_c = 2W$ (on $40 \times 40 \times 0.7$ mm ceramic board.)
- 3) Complements the 2SC5053.

● Packaging specifications and h_{FE}

Type	2SA1900
Package	MPT3
h_{FE}	Q
Marking	AL*
Code	T100
Basic ordering unit (pieces)	1000

* Denotes h_{FE}

● Electrical characteristics ($T_a=25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	-60	—	—	V	$I_C = -50\mu A$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	-50	—	—	V	$I_E = -1mA$
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	-5	—	—	V	$I_E = -50\mu A$
Collector cutoff current	I_{CBO}	—	—	-0.1	μA	$V_{CB} = -40V$
Emitter cutoff current	I_{EBO}	—	—	-0.5	μA	$V_{EB} = -4V$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	—	—	-0.4	V	$I_C/I_S = -500mA/-50mA$
DC current transfer ratio	h_{FE}	120	—	270	—	$V_{CE} = -5V, I_E = 50mA, f = 100MHz$
Transition frequency	f_T	—	150	—	MHz	$V_{CE} = -5V, I_E = 50mA, f = 100MHz$
Output capacitance	C_{OB}	—	20	—	pF	$V_{CE} = -10V, I_E = 0A, f = 1MHz$

(96-115-B352)

Medium Power Transistor (50V, 1A)

2SC5053

● Features

- 1) Low saturation voltage, typically $V_{CE(sat)} = 0.12V$ at $I_C / I_S = 500mA / 50mA$.
- 2) $P_c = 2 W$ (on $40 \times 40 \times 0.7$ mm ceramic board.)
- 3) Complements the 2SA1900

● Packaging specifications and h_{FE}

Type	2SC5053
Package	MPT3
h_{FE}	QR
Marking	CG*
Code	T100
Basic ordering unit (pieces)	1000

* Denotes h_{FE}

● Electrical characteristics ($T_a=25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	60	—	—	V	$I_C = 50\mu A$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	50	—	—	V	$I_E = 1mA$
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	5	—	—	V	$I_E = 50\mu A$
Collector cutoff current	I_{CBO}	—	—	0.1	μA	$V_{CB} = 40V$
Emitter cutoff current	I_{EBO}	—	—	0.1	μA	$V_{EB} = 4V$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	—	—	0.4	V	$I_C/I_S = 500mA/50mA$
DC current transfer ratio	h_{FE}	120	—	390	—	$V_{CE} = 5V, I_E = 50mA, f = 100MHz$
Transition frequency	f_T	—	150	—	MHz	$V_{CE} = 5V, I_E = 50mA, f = 100MHz$
Output capacitance	C_{OB}	—	15	—	pF	$V_{CE} = 10V, I_E = 0A, f = 1MHz$

(96-196-D352)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331